

99-0219

Invenția se referă la domeniul fotografiei cu semiconductori fără argint.

Purtătorul conține un substrat dielectric pe care consecutiv sunt plasați primul electrod, un strat fotoinjector cu conductibilitatea de tip p, un strat de semiconductor calcogenic vitros și al doilea electrod, în care stratul fotoinjector este confecționat din zece perechi de semistraturi alternându-se, cel inferior este confecționat din As_2Se_3 cu grosimea de 8-10 nm, iar cel superior din In_2S_3 cu grosimea de 10-12 nm sau din In_2Se_3 cu grosimea de 40-50 nm, stratul de imprimare având grosimea de 0,2-0,5 μm , iar al doilea electrod fiind confecționat din aluminiu cu grosimea de 10-50 nm.

Rezultatul constă în majorarea sensibilității la lumină a purtătorului de informație.